

1.29. Разность потенциалов на концах термопары и связана с перепадом температур соотношением (по условию задачи, удельную термоЭДС можно считать постоянной):

$$U = \alpha (T_1 - T_2) \quad (1)$$

Согласно условию задачи, при  $T_1 = 200^\circ\text{C}$   
 $T_2 = 20^\circ\text{C}$

имеем  $U = 1,8 \text{ мВ}$ . Учитывая соотношение (1) получаем, что

$$\alpha = \frac{1,8 \text{ мВ}}{(200 - 20)^\circ\text{C}} = 10^{-5} \frac{\text{В}}{\text{К}}$$

a). температура тающего льда  $T_3 = 0^\circ\text{C}$ .

Поэтому термоЭДС в этом случае равна

$$U = \alpha (T_1 - T_3) = 10^{-5} \frac{\text{В}}{\text{К}} \cdot (200 - 0) \text{К} = 2 \text{ мВ}$$

Ответ. 2 мВ

б). температура кипящей воды (при атм. давлении)

$$T_4 = 100^\circ\text{C}$$

$$\text{Поэтому } U = \alpha (T_1 - T_4) = 10^{-5} \frac{\text{В}}{\text{К}} \cdot (200 - 100) \text{К} = 1 \text{ мВ}$$

Ответ. 1 мВ

2.17. Удельные потери в диэлектрике пропорциональны квадрату напряженности  $E$ .

$$P_{\text{уд}} \sim E^2$$

Пусть  $d$  — толщина диэлектрика.

Тогда напряжение на конденсаторе будет равно

$$U = E \cdot d$$

А полные потери в диэлектрике будут равны

$$P_p \sim E^2 d = \frac{U^2}{d}$$

отвод теплоты от диэлектрика происходит в основном с торцов (если диэлектрик имеет большие поперечные размеры, что мы и предполагаем) и не зависит от толщины диэл-ка.

По условию задачи

$$U = 15000 \text{ В при } d = 4 \text{ мм}$$

$$V = ? \quad \text{при} \quad d = 2 \text{ мм}$$

$$\text{отсюда находим} \quad V = U \sqrt{\frac{d'}{d}} = 15 \text{ кВ} \cdot \sqrt{\frac{2 \text{ мм}}{4 \text{ мм}}} = 10,6 \text{ кВ}$$

ответ. пробой произойдет при частоте напряжения 10,6 кВ

### 3.7. МАГНИТНЫЕ ПОТЕРИ НА ГИСТЕРЕЗИС ( $f$ -ЧАСТОТА).

$$P_f = \eta f B_{\max}^n \quad (1)$$

$B_{\max}$  — МАКСИМАЛЬНАЯ МАГН. ИНДУКЦИЯ,

$\eta$  — КОЭФФИЦИЕНТ, ЗАВИСЯЩИЙ ТОЛЬКО ОТ МАТЕРИАЛА  
(точное значение  $\eta$  не поддается при решении задачи).

ПОТЕРИ НА ВИХРЕВЫЕ ТОКИ

$$P_{BT} = \xi f^2 B_{\max}^2 \quad (2)$$

$\xi$  — коэф. зависящий только от материала.

По условию задачи при  $f = 2 \text{ кГц}$ :

$$P_f = P_{BT} = 2 \frac{BT}{kT}$$

ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ  $P_c = P_f + P_{BT}$  при  $f' = 400 \text{ Гц}$ ,  
считая, что  $B_{\max}$  имеет то же значение, что и при  $f = 2 \text{ кГц}$ .

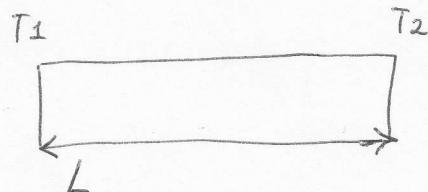
Учитывая что получаем, что из (1) и (2) следует

$$P_c = 2 \frac{BT}{kT} \cdot \frac{f'}{f} + 2 \frac{BT}{kT} \cdot \left( \frac{f'}{f} \right)^2, \text{ где } \frac{f'}{f} = \frac{400 \text{ Гц}}{2 \text{ кГц}} = \frac{1}{5}$$

$$\text{получим } P_c = 0,48 \frac{BT}{kT}$$

$$\underline{\text{ОТВЕТ. }} P_c = 0,48 \frac{BT}{kT}$$

### 4.18. ОБОЗНАЧИМ ИСКОМУЮ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ЧЕРЕЗ $U$ .



$$\Delta T = T_1 - T_2$$

$L$  — ДЛИНА ОБРАЗЦА.

$S$  — СЕЧЕНИЕ

ТАККАК ПОЛУП-К СОБСТВЕННОЙ, ТО  
КОНЦЕНТРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И ДЫРОК РАВНО

$$n = p = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{\Delta W}{2kT}}, k — \text{ПОСТОЯННАЯ БОЛЬЦМАНА.}$$

$$\text{ГДЕ } N_c = 2 \left( \frac{2\pi m_n kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$N_v = 2 \left( \frac{2\pi m_p kT}{h^2} \right)^{3/2}, h — \text{ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА.}$$

Разность потенциалов  $U$  привела бы к току

$$I_1 = \frac{U}{L} S (\sigma_n + \sigma_p)$$

$$\text{ГДЕ } \sigma_n = e \mu_n n, \sigma_p = e \mu_p p$$

Учитывая, что  $p = n$  получаем

$$I_1 = \frac{US}{L} e n (\mu_n + \mu_p) \quad (1)$$

ЭТЫЙ ТОК УРАВНИВАЕТСЯ диффузионным током, который возникает из-за разности концентраций носителей на торцах образца:

$$I_2 = e \left( D_C \frac{\Delta n_c}{L} - D_V \frac{\Delta n_v}{L} \right) S \quad (2)$$

ГДЕ коэф. диффузии равны  $D_C = \frac{kT}{e} \mu_n$  и  $D_V = \frac{kT}{e} \mu_p$

Учитывая зависимость  $n_c$  и  $n_v$  от температуры получаем

$$\Delta n_c = n \cdot \left( 3 \frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta W}{2kT^2} \Delta T \right)$$

$$\Delta n_v = \Delta n_c$$

Подставляя это в у-ие (2) находим, учитывая (3)

$$I_2 = e \cdot \frac{kT}{e} (\mu_n - \mu_p) \cdot \frac{S}{L} \cdot n \cdot \frac{\Delta T}{T} \left( 3 + \frac{\Delta W}{2kT} \right) = \\ = \frac{S}{L} n e (\mu_n - \mu_p) \cdot \left( \frac{3kT}{e} + \frac{\Delta W}{2e} \right)$$

Приравнивая токи  $I_1$  и  $I_2$  находим

$$\frac{U_S}{L} e n (\mu_n + \mu_p) = \frac{S e n}{L} (\mu_n - \mu_p) \left( \frac{3kT}{e} + \frac{\Delta W}{2e} \right) \frac{\Delta T}{T}$$

откуда  $U = \frac{\mu_n - \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \cdot \left( \frac{3kT}{e} + \frac{\Delta W}{2e} \right) \frac{\Delta T}{T}$

[При расчете имеем вспомогательную тем, что  $\frac{kT}{e} = 0,026$  В при  $T = 300$  К, т.е.  $\frac{kT}{e} = 0,043$  В при  $T = 500$  К]

Подставляем числовые данные

$$U = \frac{2-1}{2+1} \cdot \left( 3 \cdot 0,043 \text{ В} + \frac{0,665 \text{ эВ}}{2e} \right) \frac{\Delta T}{T} = \\ = \frac{1}{3} \left( 3 \cdot 0,043 \text{ В} + 0,3325 \text{ В} \right) \frac{10}{500} \approx 0,003 \text{ В}$$

Ответ. 3 мВ